NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR

DESCRIPTION:

The **ASI BLV33** is a Common Emitter Device Designed for Class A Television Applications.

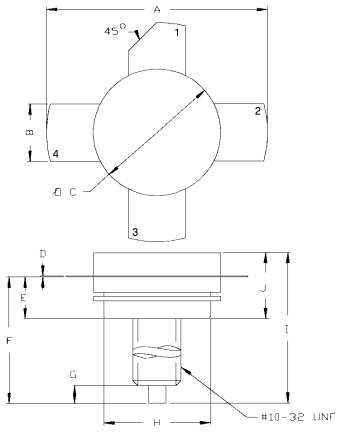
FEATURES INCLUDE:

- Gold Metalization
- Emitter Ballasting

MAXIMUM RATINGS

I_C	12.5 A
V_{CESM}	65 V
V_{CEO}	33 V
P_{DISS}	132 W @ T_C = 25 °C
T_J	-65 °C to +200 °C
T_{STG}	-65 °C to +150 °C
θ_{JC}	1.5 °C/W

PACKAGE STYLE .500 4L STUD



1 = COLLECTOR 2 & 4 = EMITTER
3 = BASE

	MINIMUM Inches/mm	MAXIMUM Inches/mm
A	1.010/25,65	1.050/26,67
B	220/5,59	.230/5,84
C	495/12,57	.505/12,83
D	.003/0,08	.007/0,18
E	.160/4,06	180/4,57
F	622/15.80	
G	.100/2,54	.130/3,31
H	.415/10,54	.425/10,80
I	.720/18,29	
J	250/6,35	.290/7,37

ORDER CODE: ASI10498

CHARACTERISTICS T_C = 25°C

SYMBOL	TEST CONDITIONS			MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
BV_{CEO}	I_C = 100 mA			33			V
BV_{CES}	I_C = 25 mA			65			V
BV_{EBO}	I_E = 10 mA			4.0			V
I_{CES}	V_{CE} = 30 V					10	mA
h_{FE}	V_{CE} = 25 V	I_C = 3.0 A		15		100	---
C_c	V_{CB} = 25 V		f = 1.0 MHz		155		pF
C_{re}	V_{CE} = 25 V	I_C = 100 mA	f = 1.0 MHz		88		
C_{cs}	V_{CE} = 25 V	I_C = 100 mA	f = 1.0 MHz		3.0		
f_T	V_{CB} = 25 V	I_E = 3.0 A			680		MHz
	V_{CB} = 25 V	I_E = 6.0 A			750		
G_P	V_{CE} = 25 V	I_C = 3.2 A	P_{out} = 19 W	9.0	9.7		---
	f = 224.25 MHz						

Specifications are subject to change without notice.

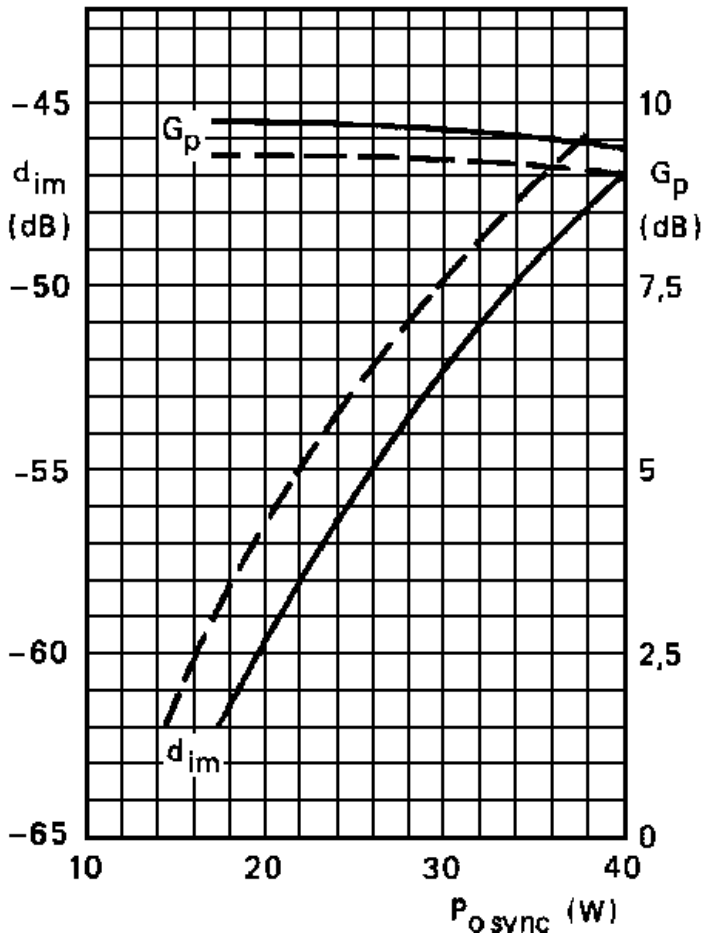


Fig. 1 Intermodulation distortion (d_{im}) and power gain as a function of output power.

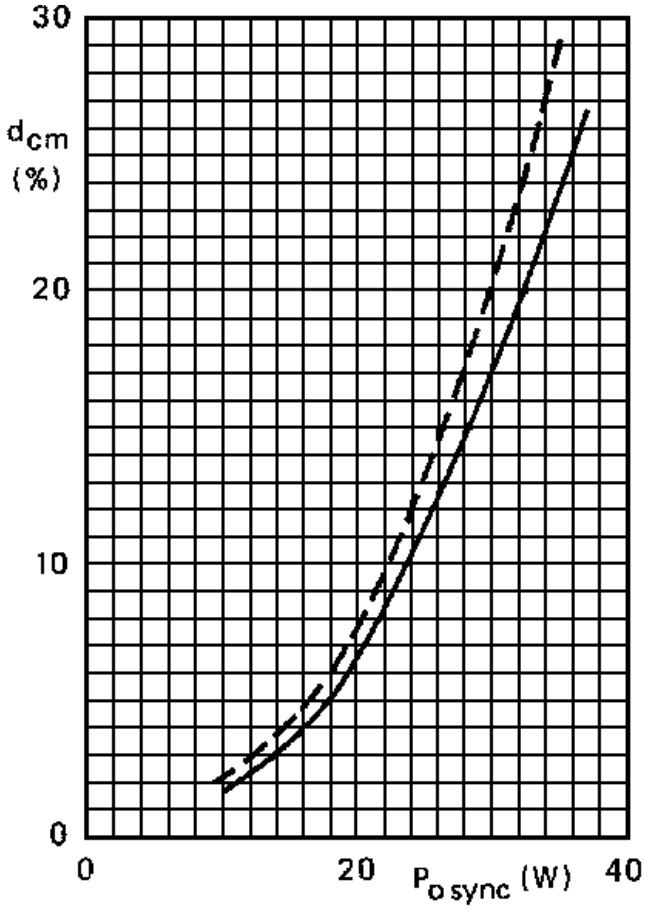


Fig. 2 Cross-modulation distortion (d_{cm}) as a function of output power.

Conditions for fig. 1 and 2:
Typical values; V_{CE} = 25 V; I_C = 3.2 A; T_h = 25°C – T_h = 70°C; f_{vision} = 224.25 MHz.

Specifications are subject to change without notice.

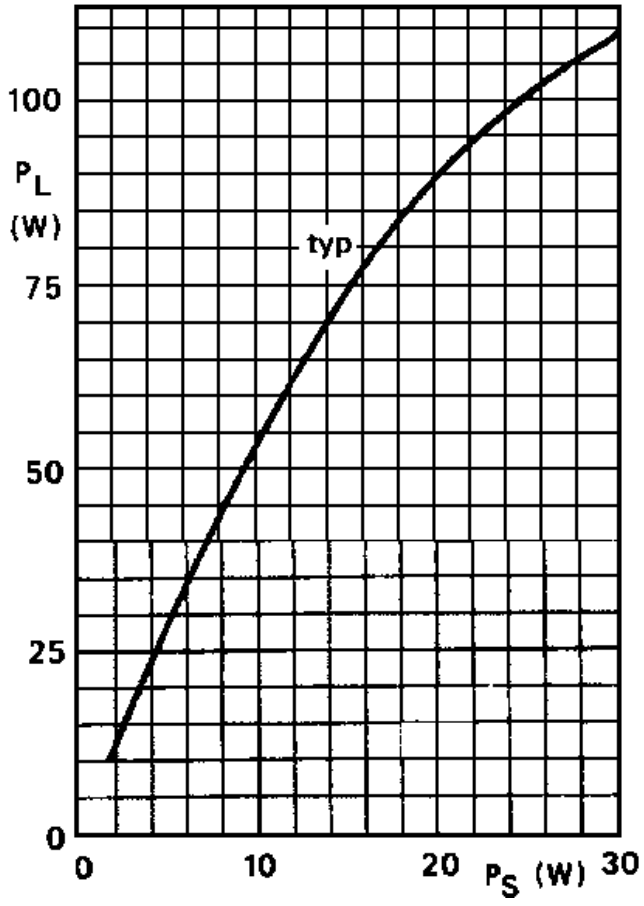


Fig. 3 V_{CE} = 28 V; $I_{C(ZS)}$ = 100 mA; T_h = 70 °C; f_{vision} = 224.25 MHz.

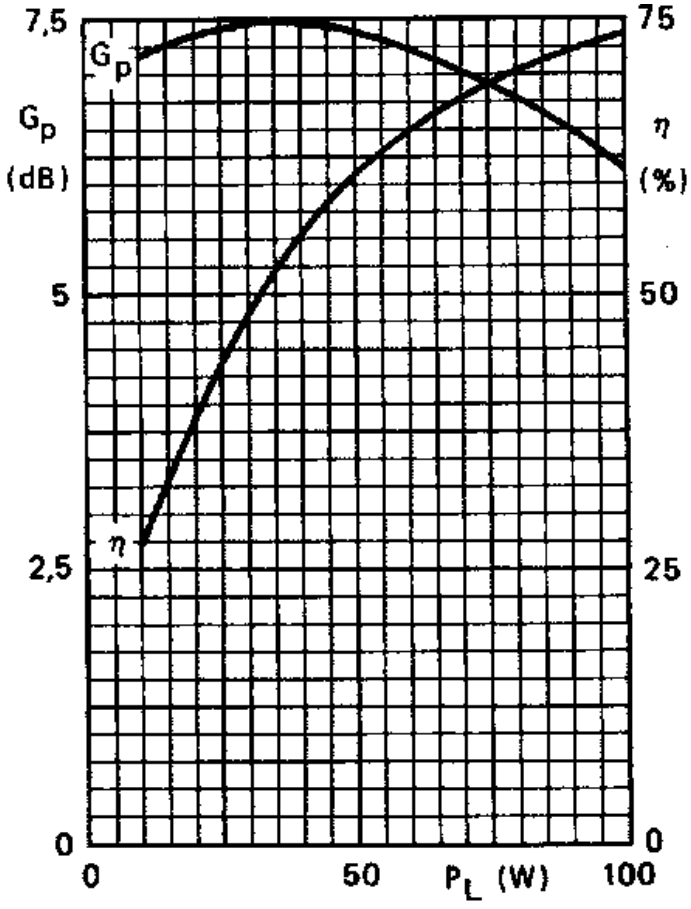


Fig. 4 V_{CE} = 28 V; $I_{C(ZS)}$ = 100 mA; T_h = 70 °C; f_{vision} = 224.25 MHz; typical values.

Specifications are subject to change without notice.

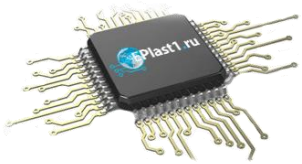
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.